



DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMHALAMAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xii
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.2.1. Batasan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1. Isi Tinjauan Pustaka	8
II.2. Penulisan Acuan	11
BAB III DASAR TEORI	12
III.1. Silikon Karbida (SiC).....	12
III.2. Sambungan Logam-Semikonduktor.....	17
III.3. <i>Schottky-Mott Limit</i>	21
III.4. Mekanisme Transpor Arus.....	22
III.5. Dioda Schottky.....	26
III.6. Persamaan Dioda Schottky	30
III.7. PARAMETER KARAKTERISTIK DIODA SCHOTTKY	32
III.8. HIPOTESIS.....	33
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN	34
IV.1. Alat dan Bahan Penelitian.....	34
IV.2. Tata Laksana Penelitian	37





IV.3. Rencana Analisis Hasil Penelitian	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
V.1. Hasil Penelitian	49
V.2. Analisis Karakteristik Dioda Schottky Au/4H-SiC.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
VI.1. Kesimpulan	62
VI.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68
LAMPIRAN A: Proses Pemotongan dan Pembersihan Semikonduktor	68
LAMPIRAN B: Proses Deposisi dan <i>Annealing</i>	68
LAMPIRAN C: Proses Karakterisasi Elektrik.....	69
LAMPIRAN D: Grafik Ekstraksi Karakteristik Elektrik.....	70

